ガラスの化学結合状態の解析と計算機化学

1) ガラスの構造は正しく理解されているか?

2)計算はガラス構造をどれ程忠実に再現しているか?

1. はじめに

たとえば、SiO₂にNa₂Oを添加していくと、架橋 酸素BOは減少し非架橋酸素NBOが生成する。

$$\equiv Si - O - Si \equiv + Na_2O \rightarrow$$
$$\equiv Si - O^{(*)} \xrightarrow{Na} O^{(*)} - Si \equiv$$
(1)

式を見る限り, Na⁺はNBOの負電荷を補償するため に1:1の相互作用をしているように見える。また, B₂O₃にNa₂Oを添加していった場合,Na₂Oの添加量 が30mol%程度まではNBOは生成せず、代わりに酸 素を4配位したホウ素が生成することが知られて いる。[BO_{4/2}]多面体はNBOと同様に1-の負電荷を 帯びているため、やはりNa⁺との相互作用により局 所的な電気的中性が保たれる。実際に, XPSやNMR で見積もられたNBOや4配位ホウ素の割合などと いった基本構造単位の量は、式(1)のような反応式 から予想される値と一致する。XPSの場合、内殻 軌道のOlsによるピークはNa2O-SiO2系ガラスでは BO成分とNBO成分に明瞭に分離することが知ら れている。各ピーク成分の強度比はNa2O添加量に 対して連続的に変化するが、それと同時にピーク 位置も変化することが知られている。

一般に、内殻電子の束縛エネルギーは化学結合 性や電子密度に対応付けて解釈されることが多 い。例えば、Olsピークの低束縛エネルギー側への シフトは、酸素-カチオン間のイオン結合性が増加 することにより酸素の電子密度が高まったことを 反映した現象と理解されているようである。内殻 電子の束縛エネルギー変化は定性的には次のよう に説明できる。電子密度が高い状態から低い状態 に変化すると、原子核の正電荷を電子が遮蔽でき なくなるので、内殻電子が原子核に近づいて原子 核の静電力を遮蔽しようとする。その結果、内殻 電子の束縛エネルギーは大きくなる。逆に、電子 岡山大学環境理工学部 難波徳郎 tokuro_n@cc.okayama-u.ac.jp

密度が増加するとOlsのような内殻電子の束縛エ ネルギーは低エネルギーシフトを示す。これより, イオン結合性が増し電子が酸素に偏っているので あれば,Siは相対的に電子を失うことになるので, SiのXPSピークはOlsとは逆方向にシフトするはず である。しかし実際には,Si2pピークもNalsピー クもOlsと同じ方向にシフトする。

この何年来,筆者の研究グループではXPSによ るガラスの電子状態の解析に精力的に取り組んで きたが,上記の例のように従来の一般常識や教科 書に書かれているような構造イメージでは説明で きない現象に数多く直面してきた。実験事実をう まく説明するためには,ガラスというものに対し て私自身が抱いていた常識やイメージ(先入観) を修正する必要があった。もちろん分子軌道計算 は理論的解釈には不可欠のツールであるが,ガラ ス構造や化学結合状態の変化を直感的に理解する には(筆者には)難しすぎる。そこで,筆者の恥 ずかしい誤解を披露することにあるかもしれない が,拙稿ではガラスの構造や結合状態に対して私 が勝手に描いたイメージ(定性的かつ直感的な解 釈)を皆さんに紹介する。

2. XPSから見た化学結合状態

Fig.1にNa₂O–SiO₂ガラスのO1s光電子スペクト ル[1]を示した。530eV付近に現れている2本のピ ークのうち,高エネルギー側がBO成分,低エネル ギー側がNBO成分によるものである。Na₂O添加量 の増加に伴い,BO成分が減少しNBO成分が増加し ている。それぞれのピーク成分の面積比は組成か ら予想される値に非常によく一致していた。さら に,**Fig.2(a)**には各ピーク成分の束縛エネルギーの 変化を示した。注目すべきは,強度比の変化に伴 い中心(面積重心)だけがシフトしているのでは なく、BOもNBOもNa₂O量の変化とともにシフトし ているということである。BOは=Si-O-Si=, NBOは =Si-O…Naなどと模式的に表現されることが多い が、「その化学結合状態は常に一定ではなく変化す る」ということがわかる。先程説明した束縛エネ ルギー変化の定性的な解釈によれば、Olsの束縛エ ネルギーが小さくなったということはイオン結合 性が増し酸素の電子密度が増加したと理解でき る。

しかし, Fig.2(b)に示したように, Si2pとNalsの 束縛エネルギーもOlsと同じ方向にシフトしてい る。すなわち、「Na₂O含有量の増加とともに、O, Si,Naのいずれも外殻電子密度が増加している」 ことを実験事実は物語っているのである。イオン 結合性が増し酸素上に電子が局在化するのではな く、むしろ共有結合性が増し原子軌道間の重なり が大きくなっているように見える。この考え方が 正しいならば、各結合の原子軌道間の重なり部分 に存在する電子の密度(有効重なり電荷, Overlap Population, OP)が大きくなっているはずである。こ の考察の妥当性を検証するには、ガラスの構造モ デルを構築し、分子軌道計算によってOPの変化を 調べる必要がある。あいにく筆者は本系ガラスの 構造モデルを持ち合わせていない。そこで、ガラ スの代わりに結晶を用いて検証を試みた。



Fig. 1 O1s photoelectron spectra of $xNa_2O \cdot (1-x)SiO_2$ glasses.

一般に、同組成のガラスと結晶の間には構造の 類似性が認められることが多い。そこで、Table 1 に示した結晶についてDV-X αクラスター分子軌道 計算を行い、各結晶中の化学結合状態を評価した [2]。本来,化学結合性の評価には結合性OPと反結 合性OPの和で与えられるBond Overlap Population (BOP)が用いられる。しかし、反結合性OPは負の 値をとるため、軌道間で共有されている電子数 BOPを求める場合には、反結合性軌道に収容され ている電子数を加算するのではなく、減算するこ とになってしまう。XPSでは、電子が反結合性の 軌道に収容されているからといって、その寄与が 差し引かれた情報を観測しているわけではない。 そこで結合状態の評価には、結合性OPと反結合性 OPの絶対値の合計を用いた。ここでは、OPの合計 をTotal Overlap Population (TOP)と呼ぶことにす る。こうして求めたTOPをTable 1に示した。表中 のBO1とBO2はいずれも架橋酸素であるが、BO2



Fig. 2 Binding energies of (a) O1s and (b) Si2p and Na1s in $xNa_2O \cdot (1-x)SiO_2$ glasses.

は2つのSiの他にNaも配位した酸素である。表よ り、Na₂O含有量が増加するといずれの原子につい てもTOPの増加が認められる。現時点では、孤立 電子対の電子密度が加味されていないため、BOと NBOの値を直接比較することはできないが、「すべ ての原子の外殻電子密度が増加傾向にあり、XPS で観測されたピークシフトの傾向と一致してい る」ことがわかる。なお、Table 1にあわせて示し たが、分子軌道計算から求められる各原子の有効 電荷(net charge, Q_n)とピークシフトの間には相関 が認められなかったことを付記しておく。

ここで示された化学結合性の変化は、各原子周 辺の局所構造変化を反映したものなのだろうか? Table 2に局所構造に関するデータをまとめた。こ れを見ると、少なくとも配位数に関してはBOを除 き変化は認められない。NaはOを5配位(NBO×4、 BO×1)しており、NBOはNaを4配位でともに変化は ない。しかし、BOに関してはNa₂O成分の増加に伴 いBOに配位するNaの数が増えていることがわか る。Na-BOとNa-NBOの距離は同程度であり、見 かけ上両者の相互作用に差はない。したがって、

Table 1 Chemical bonding character of silicate crystals(a) bond overlap population, BOP

crystal /		overlap po	overlap population		
bond		bonding	anti-bonding	- DOF	
SiO ₂ *	/				
Si-	BO1 ×4	0.633	-0.001	0.632	
Na ₂ Si ₂	O5* /				
Si-	BO1 ×1	0.654	-0.019	0.635	
	BO2 ×2	0.623	-0.028	0.595	
	NBO $\times 1$	0.851	-0.007	0.844	
Na-	BO2 ×1	0.052	-0.020	0.032	
	NBO ×4	0.062	-0.005	0.057	
Na ₂ SiC	$D_3 /$				
Si-	BO2 ×2	0.574	-0.065	0.510	
	NBO ×2	0.860	-0.002	0.859	
Na–	BO2 ×1	0.064	-0.009	0.055	
	NBO ×4	0.090	-0.003	0.086	

(b) total overlap population, TOP and net charge, Q_n

	SiO ₂ *	Na ₂ Si ₂ O ₅ *		Na ₂ SiO ₃		
	ТОР	$Q_{\rm n}$	TOP	$Q_{\rm n}$	TOP	Q_{n}
Si	2.54	2.14	2.83	1.94	3.00	1.80
BO1	1.27	-1.03	1.35	-1.08		
BO2			1.37	-1.07	1.44	-1.09
BOave	1.27	-1.03	1.36	-1.07	1.44	-1.09
NBO			1.12	-1.10	1.23	-1.06
Na			0.34	0.76	0.45	0.71
¥ · ,	1 1. 0.	0	r a. o			

* α -cristobalite SiO₂, α -Na₂Si₂O₅

BOの電子状態はNaの影響により変化していると 考えるのが妥当である。また, BOとNBOの電子状 態に差があることは孤立電子対の数から考えても 明らかであり、Siの電子状態がNBOの配位により 変化すると考えてもよいだろう。以上の考察より, Si2pとBO1sの束縛エネルギー変化は局所構造の変 化により説明できるが、NBO1sとNa1sについては 見かけ上構造変化は認められず、ピークシフトの 根拠を局所構造変化に求めることはできない。も ちろん,分子軌道計算で直接,あるいはTable 1の ように間接的に評価できればそれが最善の方法で あることは間違いない。しかし、多くのガラスが そうであるように,正確な構造を記述することが 本質的に困難な材料に対して、「電子状態を考察す るなら分子軌道計算をやりなさい」と要求するわ けにもいかないだろう。定性的な理解の拠りどこ ろとなる概念があれば、我々凡人の前に立ちはだ かる化学結合状態という意味不明な壁もいくらか 薄く、あるいは低くなるだろう。

Table 2 Inter-atomic distance in silicate crystals

(a) α -cristobalite SiO ₂						
atomic pair		distance/Å	atomic pair		distance/Å	
Si-	0	1.59×2	0- 5	Si	1.59×1	
	0	1.60×2	S	Si	1.60×1	
			(∠Si	OSi=	148.9°)	
(b) α-N	Ja₂Si₂O	5 (O(1): BO	D1, O(2): E	302, 0	D(3): NBO)	
atomic	pair	distance/Å	atomic pa	air	distance/Å	
Na-	O(2)	2.39×1	O(1)- S	Si	1.61×2	
	O(3)	2.29×1	(∠Si	OSi=	160.0°)	
	O(3)	2.34×1	O(3) - 1	Na	2 29×1	
	O(3)	2.37×1	(J) I	Na	2.29×1 2.34×1	
	O(3)	2.60×1	ו	Na	2.31×1 2.37×1	
Si-	O(1)	1.61×1	ו	Na	2.60×1	
51	O(2)	1.64×2	Ś	Si	1.58×1	
	O(3)	1.58×1	~		1.000	
(c) Na ₂ SiO ₃			(O(1): NBO, O(2): BO2)			
atomic	pair	distance/Å	atomic pa	air	distance/Å	
Na-	O(1)	2.26×1	O(1)- N	Na	2.26×1	
	O(1)	2.29×1	1	Na	2.29×1	
	O(1)	2.45×2	1	Na	2.45×2	
	O(2)	2.40×1	S	Si	1.57×1	
Si–	O(1)	1.57×2	O(2)- N	Na	2.40×2	
	O(2)	1.68×1	S	Si	1.68×1	
	O(2)	1.67×1	S	Si	1.67×1	
	. ,		(∠Si	OSi=	137.5°)	

3. 塩基度と電子状態

筆者の研究グループでは、その理解の拠りどころとなる概念として塩基度を用いてきた[3]。ここでは、塩基度と電子状態、XPSの化学シフトの関係について説明する。

酸-塩基に対して過去に様々な概念が提案され たが、現在ではLewisの提唱した理論を基礎とする 考え方が広く受け入れられている。すなわち、電 子の受容体を酸、供与体を塩基と見なすというも ので、この定義に従うと、塩基度、あるいは塩基 性度は相手に対して電子を供与しようとする性質

(電子供与性)の尺度と理解することができる。 ガラスと酸-塩基の概念の間には歴史的にも深い 関わりがあり,酸性酸化物がガラス形成体であり 塩基性酸化物はただ単にガラスの性質を修飾する だけのもの,と考えられていた時期もあった。ガ ラスの形成能の他にも,ガラスの反応性や安定性 などの化学的性質,光の散乱や吸収などの光学的 機能,電気的・磁気的性質など,電子の関与する ほとんど全ての性質はガラスの塩基度と密接な関 係がある。

光は電磁波であり,電場と磁場を伴っている。 物質の構成要素の中で光のような振動数の高い電 磁波と直接相互作用できるのは質量の軽い電子に 限定される。これより,光と物質の相互作用に起 因する光学的機能は,電子の置かれている状態に 左右されると言える。例えば屈折率について見る と,屈折率の高い物質とは光によって変位を受け やすい電子を多く含む物質であると理解すること ができる。この電子変位の受けやすさを表現する ものは分極率であり,一般にアニオンはカチオン よりも高い分極率をとる。結局のところ,ガラス の光学的機能を支配するのはアニオンの分極状態 であり,酸化物ガラスでは酸化物イオンというこ とになる。ガラスの塩基度は,ガラス中のアニオ ンの分極状態を表す指標でもある。

このように酸化物ガラスの場合,ガラスの塩基 度は酸素の電子供与性や分極状態,つまり酸素の 電子状態で表現することができる。それでは,塩 基度の高い酸素とはどのような状態にあるものな のだろう?供与される電子は酸素が過剰に有する 電子であり,過剰電子の存在は電子雲の広がりを もたらす。電子雲が大きく広がった状態というの は,換言すると分極しやすい状態ということにな る。また,電子の授受は結合軌道を介して行われ るため,過剰電子が存在するのは価電子帯,ある いはその周辺の外殻軌道である。これらをまとめ ると,外殻電子密度が高く分極しやすい状態にあ る酸素が塩基度の高い酸素であると言える。外殻 軌道の電子密度と内殻電子の束縛エネルギーの関 係については冒頭で述べたとおりであり,外殻電 子密度が高い場合内殻電子は原子核から遠ざかる ことで核電荷の遮蔽力のバランスをとる。

束縛エネルギーの化学シフトについて,若干定 量的な説明を加えておく。原子を内部が空洞の球 とみなす大胆なモデルによれば、原子内部(空洞 部分)のポテンシャルは一様であり、表面の殻の 電荷qと半径r_vによりq/r_vで与えられる。殻の電荷が Δq変化した場合,内部のポテンシャルは一様に Δq/r_vだけ変化する。この時, 殻の内部に閉じ込め られた全ての電子の束縛エネルギーも一様にΔq/r_v シフトする[4]。この殻を価電子殻に置き換えて考 えると、「価電子殻の作るクーロン場は価電子殻の 電荷(電子密度)の変化に応じて一様に変化する」 と考えることができる。XPSで観測される化学シ フトの定量的な説明としてはいささか大胆すぎる ようにも思うが、大まかな近似として電荷の変化 によりΔq/r_vの化学シフトが起こると考えてもよさ そうである。

実際には、分子軌道計算により求めた有効電荷 Q_nとXPSピークシフトの間には相関は認められな かった。有効電荷は、軌道の重なりにある電子をA という原子とBという原子の両方に属すると考え るのではなく、AかBのいずれか一方に分配すると いう考え方に基づいている。有効重なり電荷OPの 絶対値の合計TOPは、軌道の重なりに存在する電 子の密度を表している。TOPとXPSピークシフトに 良好な相関が認められたということは、「軌道の重 なりに存在するすべての電子はAとB双方のクー ロン場に影響を与えている」と理解するのが妥当 である。

もう一度Fig.2を見直してみると、O1s、Si2p、 Nalsはいずれも同じ方向にシフトしている。これ はこれまで繰り返し指摘してきたとおりである が、さらに注目すべきはシフト量がほぼ同程度で あるということである。Si2pは平均のO1sと, Na1s はNBO1sとほぼ同じ傾きでシフトしているように 見える。これは偶然だろうか?ガラス中の全ての 酸素はSiと結合しており、またTable 2に示した結 晶を参考にするならばNaには5個の酸素が配位し ており、そのうち4個はNBOである。これより、Si もNaも近接する酸素が作るクーロン場の影響を直 接受けているように見える。直接影響を受けるこ と自体はこれまでの議論からすると決して不思議 なことではないが、「カチオンの内殻電子も酸素の 作るクーロン場に覆われている」かのように見え る、つまり「SiやNaの外殻電子は自分自身の内部 クーロン場にほとんど影響を及ぼしていない」よ うに見えるのである。分子軌道計算から求めた状 態密度(Density Of States, DOS)によると、価電子帯 の主たる構成成分はO2pであり、SiやNaの寄与はわ ずかでしかない。このことからも「SiやNaといっ たカチオンの内殻電子の束縛エネルギーを支配し ているのは酸素の電子状態である」と結論付ける ことができる。

だからといって、SiやNaが役に立たないただの おまけなどと主張するつもりはまったくない。次 に説明するように、酸素の電子状態を支配してい るのはまぎれもなくSiやNaなのだから。

4. 塩基度の算定方法

ガラスの塩基度を実験的に求める方法には、酸 化物イオンの活量を測定する方法、光吸収スペク トルを測定する方法、電子スピン共鳴(ESR)スペク トルを測定する方法などがある。DuffyとIngram[5] の提案した光学的塩基度は二番目の手法のひとつ である。彼らは、TI⁺、Pb²⁺、Bi³⁺イオンなどの ns^2 電子配置を持つイオンの¹S₀→³P₁遷移による紫外 光吸収ピークがガラス組成に対して敏感に変化す ることに注目した。吸収ピーク波数の化学シフト はプローブイオンの外殻電子密度の変化にもとづ く現象であり、マトリックスガラスからプローブ イオンに供与される電子の量的変化に対応する。 このような考え方にもとづいて、彼らは吸収ピー ク波数の化学シフトをマトリックスガラスの光学 的塩基度Aと定義した。DuffyとIngram[6]はさらに 単純酸化物 M_mO_n のAとカチオンのPauling電気陰性 度 χ の間にA=0.75/(χ -0.25)なる関係が成り立つこ とを見出し、これを多成分系に拡張した次式を提 案した。

$$\begin{cases} \Lambda_{cal} = 1 - \sum_{i} \frac{z_{i} r_{i}}{2} \left(1 - \frac{1}{\gamma_{i}} \right) \\ \gamma_{i} = 1.36(\chi_{i} - 0.26) \end{cases}$$
(2)

ここで、 c_i はi種カチオンの原子価、 r_i は酸素1個当たりで表現したときのi種カチオンの数(カチオンと酸素の比, m/n)である。また、 γ_i はbasicity moderating powerと呼ばれるパラメータで、単純酸化物の光学的塩基度の逆数、 $1/\Lambda$ に相当する。

 Λ_{cal} のような量を用いることにより,異なるガラ ス系であっても同じ土俵で比較することが可能に なる。**Fig.3**に種々のアルカリ二成分系ガラスの Ols束縛エネルギーの実測値(面積重心)と式(2) で求めた塩基度 Λ_{cal} の関係をプロットした。TeO₂ 系とBi₂O₃系を除いてプロット点は同じ領域に位 置しており,塩基度とOls束縛エネルギーの間には



Fig. 3 Correlation between experimentally obtained XPS O1s binding energy and a mathematical expression of optical basicity Λ_{cal} .

1対1の対応関係が認められる。d軌道の寄与により 高い共有結合性を持つ遷移金属酸化物の場合,塩 基度の算定値と実測値が異なると言われている [7,8]。TeO₂系ガラスは紫外から可視光の領域に吸 収端を有するため,プローブイオンの吸収ピーク を観測することができない。したがって,算定値 の妥当性の検証に必要な光学的塩基度の実測値を 得ることができない。

TeO₂にアルカリ酸化物を加えていくと、TeO₄三 方両錐からNBOを含むTeO,三方錐へと変化するこ とが知られている。アルカリ酸化物の増加ととも にNBOも増加するにもかかわらず, XPSではOls シグナルは単一の成分として観測され,SiO,系の ようにBOとNBO成分にシグナルを分離すること はできない[9]。Himeiら[9]は、Te5d-O2p π軌道を 介したO→Te方向の電子の逆供与により価電子殻 の電子密度が均等化されOlsシグナルは単一成分 として観測される、と考察した。SiO2系の場合Si-O 結合のπ結合性はTe-O結合よりも低いためO2p孤 立電子は酸素上に局在しやすいのに対し、TeO2系 ではO2pから空のTe5dへ電子が供与されるため価 電子殻の電子が非局在化する、と考えられる。SiO2 系ではO2p電子雲の広がり(軌道の重なり)はせい ぜい最近接のSiおよびNaまでであるのに対して、 TeO2系では第二近接以上にまで電子雲が広がって いると考えるのが妥当であろう。Te⁴⁺の分極率 (1.595 Å³)はSi⁴⁺(0.033 Å³)に比べて非常に大きい [10]ことから、Te自身の電子雲もまたSiに比べて大 きく広がっており、軌道間の重なりも大きくなっ ていることが予想される。π軌道を介して電子が非 局在化することにより,酸素の価電子殻には最近 接Teに配位した酸素(第二近接酸素)からも電子 が流れ込み、電子密度は非常に高くなると考えら れる。このようなTeを隔てた第二近接酸素間の軌 道の混合は分子軌道計算においても確認されてい る[11]。以上により、TeO2系のO1s束縛エネルギー は他のガラス系よりも低い値を示すという実験事 実をうまく説明することができる。以上の考察は Bi₂O₃系ガラスに対しても適用できるはずである。

さて、先ほども述べたようにTeO₂系とBi₂O₃系ガ ラスを除くと塩基度 Λ_{cal} とO1s束縛エネルギーの間 には1対1の対応関係が認められる。そこで, Na₂O-SiO₂系ガラスについて両者の関係を1次関数 で近似した(Fig.3)。

 $E_{B}(O1s) = 12.94 \times \Lambda_{cal} + 538.7$ (eV) (3) 式(2)と(3)より任意の組成のガラスの塩基度とO1s 束縛エネルギーを予測することができる。これより、測定結果の妥当性を評価することが可能になる。もちろん、TeO₂のようにπ結合性が高い成分を 含む場合には注意が必要である。

DuffyとIngram[6]はmicroscopic optical basicityと いう概念も提唱した。これは局所構造グループ中 の酸素の塩基度を算定するもので、Λの代わりにλ という記号で表されている。ここではλをgroup basicityと呼ぶことにするが、計算には式(2)をその まま適用することができる。いくつかの構造グル ープについてgroup basicityを算出し、あわせてO1s 束縛エネルギーも見積もった(Table 3)。このよう にOls束縛エネルギーを算定することにより、Ols シグナルを複数成分に分離した場合、分離された ピーク成分の帰属やピーク分離そのものの妥当性 の評価が可能になる。たとえば、B3-NBOとSi-NBO のOlsはそれぞれ529.5および529.2eVと非常に接 近した値をとるため、「ボロシリケートガラス中の NBOはBとSiのどちらに配位したNBOなのかXPS では区別できない」と言える。このNBOの束縛エ ネルギーの算定値はNaが配位していない場合、あ

Table 3 Estimated group basicity and O1s binding energy of the individual oxygen in the various structural groups.

Structurul Broups.						
structural group	group basicity, $\lambda / -$	O1s binding energy /eV				
B3-O-B3*	0.42	533.2				
Si-O-B3	0.45	532.9				
Si-O-Si	0.48	532.5				
B3-O-B4	0.49	532.3				
Si-O-B4	0.52	532.0				
Al4–O=Al4×2	0.54	531.7				
B4OB4	0.57	531.4				
Si-O-Al4	0.59	531.1				
Al4-O-Al4	0.69	529.7				
B3–NBO	0.71	529.5				
Si-NBO	0.74	529.2				
B4–NBO	0.78	528.6				
Si–NBO–Na	0.81	528.2				
Al4–NBO	0.85	527.7				

* Bn, Aln: n-fold coordinated boron or aluminum

るいはLi, Ca, Srなど電気陰性度χが1.0の原子が配 位した場合に相当する。Table 3にはNaが配位した NBOとして最も単純なSi-NBO-Naという構造に対 する値も示した。NaやKのようにxが1.0より小さな 値をとる原子が酸素に配位した場合,式(2)中の (1-1/γ_i)は負の値をとるようになるため、酸素の塩 基度λは増加することになる。逆に多くの金属がそ うであるように、χが1.0より大きな原子が酸素に 配位するとλは減少する。一般にNBOよりもBOが 小さな塩基度を有しO1sピークが高束縛エネルギ ー側に現れるという実験事実をうまく説明するこ とができる。いわゆる4配位Alのトライクラスター (Table 3中のAl4-O=Al4×2)がもしガラス中に生成 したとすれば、Al4-O-Al4のBOよりも2eV程度高 束縛エネルギー側に現れると予想できる。また, 冒頭に示したNa₂O-SiO₂ガラスのBO, NBO, 平均 Olsのピークシフトについては次のように説明す ることができる。平均Olsはガラス全体の酸素の電 子状態の文字通り平均を表すもので、Na₂O成分の 増加によりガラス全体を覆うO2p電子雲の電子密 度が上昇する。Si-Oπ軌道を通じてO2pローンペア 電子,特にNBOのO2p電子は非局在化するが,そ の割合はそれ程高くないのでBOとNBOのO2p電子 密度は完全には平均化されずXPSではそれぞれ異 なる位置にピークを与える。BO1sのシフトが NBO1sに比べて大きいのはBOにもNaが配位する ようになるためであり、NBO1sのシフト量が相対 的に小さいのは周辺の局所構造にあまり大きな変 化がないためである、と理解することができる。

しかし、このgroup basicityはいかなる構造グルー プについても適用可能というわけではない。それ ぞれの化合物が持ち込む酸素の量を見積もること ができないと算定不能となる。たとえば、Si-O-Si にNaが配位したBOについて考えると、SiO₂とNa₂O それぞれが持ち込む酸素の割合はどのように考え ればよいのだろう?Naが配位しないBOに比べて 束縛エネルギーは低くなることはわかっても、何 eV低くなるかは予測できない。酸素の寄与をSiO₂ やNa₂Oなどといった化合物に分けて考える算定方 法にはやはり限界があると言える。化合物ではな く,Na₁Si₂O₁などといったように構造グループ内の 原子比から直接算定することができれば、応用の 幅はもっと広がるだろう。このような考え方に基 づいた算定方法が化学シフトパラメータとして筆 者のグループが提案しているものである[3]。

化学シフトは各結合原子に固有なパラメータp の和で表現できるというJolly[12]の考え方を参考 に次のような式を考えた。

 $E_{\rm B}({\rm O1s}) = \sum c_i p_i + c \tag{4}$

ガラスでは結合原子の種類とその数を特定できな い場合のほうが多いため、ガラス組成あるいは構 造グループの化学組成を直接反映することができ る量の方が有効である。そこで、Jollyの考え方を、 構成原子に固有なパラメータ(Chemical Shift Parameter, CSP)の和でO1s束縛エネルギーを表現 できる、というように修正した。酸素も含めた構 成原子毎にCSPを規定することにより、アルカリ が配位したBOやNBO, SiO4四面体やBO3三角形な どといった局所構造単位について個々のO1s束縛 エネルギーを容易に求めることができるようにな る。そこで、 $E_{\rm B}(O1s)$ の算定値と実測値が一次関数 で相関付けられるように経験的にCSPを求めた (Fig.4)。実験値と算定値の間に良好な直線関係が 成り立っているのは、 パラメータの由来からして 当然のことであるが、構成原子に固有なパラメー タを規定するといった考え方の利点は他にもあ



Fig. 4 Correlation between O1s binding energies, $E_{\rm B}({\rm O1s})$ obtained from experiment and estimation.

る。すなわち、Ols以外にもSi2pやBlsなどあらゆ る構成元素についてCSPを規定することが可能な のである。これについては別の機会に紹介したい。

5. 応用例

塩基度の概念にもとづく化学シフトの考察を Na₂O-Al₂O₃-SiO₂3成分系ガラス[13]に適用してみ る。Fig.5にNa₂O·2SiO₂ダイシリケートのNa₂Oを Al₂O₃で置換していった場合のOlsシグナルの変化 を示した。Al₂O₃置換によりNBOが減少し、Na₂O とAl₂O₃が当モルになるとNBOが完全に消失する という,よく教科書などに登場するケースである。 当量点(x=0.5)ではガラス化しなかったが、その手 前でNBOが消失していることがわかる。BO成分は 2本のピークに分離でき、高エネルギー側のBO1を Si-O-Si結合に、低エネルギー側のBO2をSi-O-Al 結合による成分と帰属した。Fig.5に示したガラス の他に、2種類の組成シリーズ ([II]: Na₂O · yAl₂O₃ · (4-2y)SiO₂, [III]: Na₂O · zAl₂O₃ · (2-2z)SiO₂)の測定 も行っており、OlsとNalsの化学シフトをFig.6に 示した。図中にはNa₂O-SiO₂2成分系ガラスの結果 もあわせて示してある。なお、カッコ内の数字は 組成系列の番号を表している。また、図中の破線



Fig. 5 O1s photoelectron spectra for $(1 - x)Na_2O \cdot xAl_2O_3 \cdot 2 SiO_2$ glasses (Series I).

はTable 3に示した構造グループのO1s束縛エネル ギーの算定値である。本系ガラスはいずれも等量 点以下(Na₂O ≥ Al₂O₃)の組成であり,Alはすべて4 配位の状態で存在しているはずである[14]。また, Al4–O–Al4構造は負電荷を帯びた[AlO₄₂]⁻間の静 電反発[15]により,本系ガラスには存在しないと考 えられる。Al4–NBOについては,Table 3よりO1s 束縛エネルギーは528eV程度の値をとるはずであ り,Fig.6(a)のプロット範囲外に相当する。以上よ り,本系ガラスで観測された3種類のO1s成分は高 束縛エネルギー側からSi–O–SiのBO1,Si–O–Al4の



Fig. 6 Experimental XPS binding energies of O1s and Na1s in Na₂O–Al₂O₃–SiO₂ glasses as a function of optical basicity.

BO2, Si-O-NaのNBOと帰属することができる。 BO1およびNBO成分はNa₂O-SiO₂2成分ガラスと同 じ領域に現れており、ピーク分離と帰属は妥当で あると言える。Series IIIについては、やや高束縛エ ネルギー側に現れているが、この理由については 紙面の関係で省略する。

Nalsについてもプロット点はNa₂O-SiO₂2成分ガ ラスと同じ領域に現れている。一般にNaの働きと してはNBOの電荷補償の他に, [AlO_{4/2}]「多面体の電 荷補償の2通りがあると言われている。しかし, Nalsシグナルは幅が狭く対称性のよい1本のピー クとして観測された。既に説明したように, Na₂O-SiO₂ガラスではNaは主としてNBOと相互作用して おり, NalsはNBOの価電子殻に覆われる。このた め, NalsはNBOの価電子殻の作るクーロン場の変 化に応じてNBO1sとほぼ同じエネルギーシフトを 示す。Fig.6のNBO1sとNalsにも同様の連動シフト が認められる。しかし本系ガラスでは、特にseries IIでは本来連動シフトは起こらないはずである。

Series II $\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}(Na_2O \cdot yAl_2O_3 \cdot (4-2y)SiO_2)\mathcal{O}\mathcal{I}\mathcal{I}\mathcal{I}$ タはFig.6中で黒塗りのマーカーで表してある。右 端の $\Lambda \sim 0.6$ のガラスはy = 1.0つまりNa₂O · Al₂O₃ · 2SiO₂であり, Na, Al, Siのすべてが等量となる組成 である。このとき、酸素はすべてSi-O-Al4のBO2 となるはずであり、実際XPSのO1sシグナルは1つ の成分であった。連動シフトの考え方が正しいと すると、y=1.0ガラスのNalsはNBO1sではなくBO2 1sに対応した位置、つまり現在の位置よりも高束 縛エネルギー側に現れるべきである。一方, series IIの左端のガラス(y = 0)の組成はNa₂O · 4SiO₂であ りBO2は存在しないはずである。これより、Al₂O₃ 量yが0から1まで増加すると、Naの相互作用の相手 は主としてNBOからBO2に変化する。結果的に, NalsはNa₂O-SiO₂2成分系ガラスの領域から次第に 高束縛エネルギー側に外れていくはずである。し かし実際には、Na₂O-SiO₂2成分系ガラスの領域に 留まっている。これはいったいなぜなのだろう か?

Aokiら[16]によれば, y = 1.0のNa₂O · Al₂O₃ · 2SiO₂ガラスはネフェリン結晶(KNa₃Al₄(SiO₄)₄)に 類似した構造を有しているそうである。そこで Table 4にネフェリン結晶の局所構造データをまと めた。Table 2のデータと比較するとNa周辺の局所 構造が大きく異なっていることがわかる。Na₂Si₂O₅ およびNa₂SiO₃結晶ではNaには5個の酸素が配位し ておりNa-O距離は2.3~2.6Åであるのに対して, ネ フェリン結晶ではNaから2.5~2.9Åの範囲に8個の 酸素(BO2)が存在している。ガラス中においてもネ フェリン結晶と同様にNaは多数のBO2に取り囲ま れていると仮定すると,実験事実を次のようにう まく説明することができる。BO2はNBOよりも価 電子殻の電子密度は低く塩基度も小さい。したが って、Na₂O-SiO₂2成分系ガラスと同様に5個程度の BO2にNaが取り囲まれているならばNalsはもっと 高い束縛エネルギーをとるはずである。しかし, 小さな塩基度を有するBO2であっても、多数の BO2で協力しあってNaを取り囲むことで、少数の NBOが取り囲んだ場合と同程度のクーロン場を作 り出すことができる。価電子殻の作るクーロン場 の式q/r,から考えると、qを調整する他にr,を変化さ せても同じ効果が得られるはずである。つまり, Naを多数のBO2で取り囲む他に、NaとBO2の距離 を短くすればよいはずである。しかし、Na-Oは 2.3Å以下に近づくことはできないので配位数を増 やす方法が選ばれているのだろう。Naに限らず「カ チオンにはそれぞれ居心地のよいクーロン場があ って,酸素の配位数や距離を調整することで安定 な化学環境を自ら作り出している」のであろう。

6. おわりに

atomic pair		distance/Å	atomic pair		distance/Å
K-	O(2)	3.04	Na-	O(1)	2.52
	O(2)	3.04		O(2)	2.56
	O(2)	3.04		O(3)	2.62
	O(5)	2.89		O(3)	2.90
	O(5)	2.89		O(4)	2.65
	O(5)	2.89		O(4)	2.65
	O(6)	2.90		O(5)	2.56
	O(6)	2.90		O(6)	2.67
	O(6)	2.90			
O(1)	Na	2.52	O(2)	Κ	3.04
	Na	2.85		Na	2.56
	Al(1)	1.79		Al(2)	1.69
	Si(1)	1.64		Si(2)	1.68

これまでの議論で新しく見えてきたガラス構造 とはどのようなものだったか。

- SiO₂系ガラスのBOは決してSi-O-Siだけではな く,アルカリイオンが配位したものもある。
- アルカリイオンはNBOに1個だけ配位しているのではなく、複数の酸素に取り囲まれている。
- さらに、取り囲まれる酸素の数は常に一定というわけではなく、その電子状態すなわち塩基度に応じて変化する。

SiO₂系ガラスの他にも, B₂O₃系やGeO₂系などにつ いても教科書には(あくまで私に言わせれば)偽 りの常識が散見される。それらのすべてをここで 紹介することはできないが,教科書に書かれてい ることを鵜呑みにせず,自分なりに考えて納得し てから飲み込むようにすべきだと思う。言うまで もなく,私のような人間の言うことはまず最初に 疑ってかからなければならない。

本来ならば、ここで見えてきたガラス構造のイ メージを計算機で再現したガラス構造モデルと対 比させるつもりだったのだが、そこまでは時間的 な余裕がなかった。本番の講演でもここに書いた ことの一部しか説明できないと思う。ということ は、本番でも構造シミュレーションの話はできな い可能性が高いということである。この話を期待 して参加してくれた人がいるかどうかは知らない が、もしいたら前もって謝っておきたい。

最後に、本稿で採り上げたXPSデータは当研究 室のOB/OG達の貴重な遺産でもある。特に、松本 修治君(セントラル硝子)と姫井裕助君(京大化研) の両名がいなければ、考察の基盤となる信頼性の 高いデータを収集することは到底できなかった。 両君を含めすべてのOB/OGに対し、改めて謝意を 表します。

参考文献

- [1] 松本, 難波, 三浦, J. Ceram. Soc. Japan 106(4) (1998) 415.
- [2] 萩原達也, 岡山大学修士論文 (2001).
- [3] 難波,三浦,岡山大学環境理工学部研究報告, 3(1)(1998)145.
- [4] D. Briggs, M.P. Seah (Editor), Practical Surface Analysis: Volume 1 Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy, 2nd Ed., John Wiley & Sons, New York, (1990) p.120.
- [5] J.A. Duffy, M.D. Ingram, J. Non-Cryst. Solids 21 (1976) 373.
- [6] J.A. Duffy, M.D. Ingram, J. Chem. Soc. Chem. Comm. (1973) 635.
- [7] N. Iwamoto, Y. Makino, S. Kasahara, J. Non-Cryst. Solids 68 (1984) 389.
- [8] J.A. Duffy, Geochim. Cosmochim. Acta 57 (1993) 3961.
- [9] Y. Himei, Y. Miura, T. Nanba, A. Osaka, J. Non-Cryst. Solids 211 (1997) 64.
- [10] V. Dimitrov, S. Sakka, J. Appl. Phys. 79(3) (1996) 1736.
- [11] Y. Himei, T. Nanba, Y. Miura, A. Osaka, Proc. XVIII International Congress on Glass D8 (1998) 123.
- [12] W.L. Jolly, J. Amer. Chem. Soc. 92(11) (1970) 3260.
- [13] Y. Miura, S. Matsumoto, T. Nanba, T. Akazawa, Phys. Chem. Glasses 41 (2000) 24.
- [14] 作花濟夫, ガラスの科学の基礎と応用, 内田 老鶴圃, (1997) p.196.
- [15] W. Loewenstein, Am. Mineral. 39 (1954) 92.
- [16] N. Aoki, S. Yambe, H. Inoue, H. Hasegawa, I. Yasui, Phys. Chem. Glasses 27(3) (1986) 124.